

بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و

فوتونیک ایران و چهاردهمین

کنفرانس مهندسی و فناوری

فوتونیک ایران،

دانشگاه شهید چمران اهواز،

خوزستان، ایران.

۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



بررسی خواص اپتیکی غیرخطی اکسیدگرافن با استفاده از روش مدولاسیون خودفازی فضایی (SSPM)

محمد جواد مرادی، محمدعلی حداد*، معین گلستانی فر، فاطمه استواری، محمود برهانی

دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفائییه، بلوار دانشگاه، یزد، صندوق پستی: ۷۴۱-۸۹۱۹۵

m.moradi@stu.yazd.ac.ir, mahaddad@yazd.ac.ir, m.golestanifar@stu.yazd.ac.com,
ostovari@yazd.ac.ir, mborhani@yazd.ac.ir

چکیده - با کشف نانوساختارهای گرافن، مطالعه بر روی این گروه از مواد افزایش یافت. در این مقاله، ما به بررسی خاصیت اپتیکی غیرخطی اکسیدگرافن می‌پردازیم. در این پژوهش، ضریب شکست غیرخطی و همچنین پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم اکسیدگرافن رقیق شده در محلول NMP، با استفاده از روش مدولاسیون خودفازی فضایی در چهار غلظت متفاوت از نمونه اندازه‌گیری شده است. آزمایش‌ها با استفاده از لیزر پیوسته Nd:YAG با طول موج ۵۳۲ نانومتر انجام شده است. با توجه به داده‌های تجربی به دست آمده، ضرایب شکست غیرخطی و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم به ترتیب از مرتبه $10^{-7} \text{ cm}^2/\text{W}$ و 10^{-11} e.s.u. اندازه‌گیری شدند.

کلید واژه- اپتیک غیرخطی، پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم، ضریب شکست غیرخطی، اکسیدگرافن، مدولاسیون خودفازی فضایی.

Studying the optical nonlinear features of Graphene Oxide (GO) using Spatial Self-Phase Modulation (SSPM)

Mohammad Javad Moradi, Mohammad Ali Haddad*, Moein Golestanifar, Fatemeh Ostovari, Mahmoud Borhani

Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, PO Box ۸۹۱۹۵-۷۴۱

m.moradi@stu.yazd.ac.ir, mahaddad@yazd.ac.ir, m.golestanifar@stu.yazd.ac.com,
ostovari@yazd.ac.ir, mborhani@yazd.ac.ir

Abstract: The discovery of graphene nanostructures attracted a great attention in this class of materials. In this paper, we investigate the nonlinear optical properties of graphene oxide. We applied spatial self-phase modulation to estimate the nonlinear refractive index of n_2 and third-order electrical susceptibility of $\chi^{(3)}$ for graphene oxide dispersed in NMP solution at four different concentrations. A ۵۳۲ nm continuous-wave Nd:YAG laser was used in the experiment. According to obtained experimental data, the n_2 and $\chi^{(3)}$ values measured in the range of $10^{-7} \text{ cm}^2/\text{W}$ and 10^{-11} e.s.u.

Keywords: Nonlinear Optic, Third Order of Electrical Susceptibility, Nonlinear Refractive Index, Graphene Oxide, Spatial Self Phase Modulation (SSPM).

مقدمه

از سال ۲۰۰۶ تا کنون، خواص متعددی از گرافن ناب (Pristine Graphen) آشکار شده است. خواص گرافن شامل تحرک بالای بارهای الکتریکی به همراه جذب نور مرئی حداکثر تا ۳/۲٪، هدایت حرارتی عالی، استحکام بالا می باشد [۱-۳]. استوینسکی و همکارانش توانستند ساختار شیمیایی اکسید گرافن چند لایه ای را با روش های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی الکترونی بررسی کنند. طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و طیف سنجی از دست دادن انرژی الکترون بازتابی (REELS) نیز از روش هایی است که آنان برای بررسی خواص مواد فوق استفاده کردند [۴]. بیناب نگاری رامان بخشی جدایی ناپذیر از تحقیقات گرافن است. برای تعیین تعداد و جهت لایه ها، کیفیت و انواع لبه ها و اثرات اغتشاش ها مانند میدان های الکتریکی و مغناطیسی، کرنش، دوپینگ، اختلال و گروه های عملکردی از روش طیف سنجی رامان استفاده می شود [۵]. همچنین، همانطور که در ادامه بررسی خواهیم کرد، خواهیم دید که گرافن خواص نوری غیرخطی چشمگیری را از خود نشان می دهد. برای مثال در لیزرهای فوق سریع به عنوان جاذب های اشباع پذیر به کار برده می شود [۶]. برای بررسی خواص اپتیکی غیرخطی مواد از جمله گرافن از روش های مختلفی استفاده شده است [۷-۹]. در این مقاله رفتار اپتیکی غیر خطی اکسید گرافن با استفاده از روش مدولاسیون خودفازی فضایی SSPM مورد مطالعه قرار گرفته شد و ضرایب شکست غیرخطی (n_2) و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم غیرخطی χ^3 نمونه های حاوی اکسیدگرافن اندازه گیری شد.

روش آزمایشگاهی و تهیه نمونه

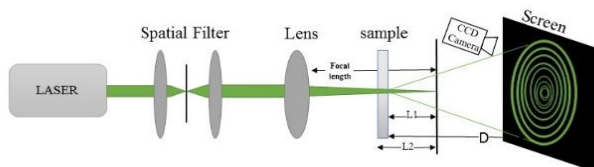
در این پژوهش محلول اکسیدگرافن کاهیده شده در حلال

نرمال متیل پیرولیدون (NMP) به عنوان نمونه های آزمایشگاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در شکل (۱)، ۴ نمونه محلول آماده شده اکسیدگرافن در NMP را نشان می دهد. برای انجام آزمایش، از لیزر پیوسته Nd: YAG ۵۳۲ نانومتر با توان حداکثر ۱۲۰ میلی وات و مشاهده پدیده SSPM در آزمایشگاه استفاده شد. شکل (۲) چیدمان نوعی SSPM را نشان می دهد.



شکل ۱: تصویر نمونه ها

در این آرایه، پرتو لیزر توسط یک عدسی همگرا به شعاع کانونی ۱۰ سانتی متر برای بررسی نمونه و تمرکز پرتو لیزر روی نمونه ها استفاده شد. با توجه به واگرایی پرتو لیزر، اندازه ی قطر کمره پرتو لیزر در کانون حدود ۳۰۰ میکرومتر



شکل ۲: چیدمان آزمایشگاهی تکنیک SSPM

تخمین زده شده است. پس از عبور پرتو کانونی شده لیزر با محلول نمونه حاوی اکسیدگرافن، طرح های پراش به صورت حلقه های متحدالمرکز بر روی صفحه دور دیده شد که این طرح ها و تعداد حلقه ها به شدت نور فرودی وابسته خواهد بود. با توجه به غیریکنواخت بودن شدت گاوسی لیزر در راستای عرضی، بخش غیرخطی ضریب شکست نمونه شدت های گوناگون لیزری را تجربه می کند که منجر به تغییر فاز در نقاط مختلف جبهه موج فرودی می شود. از

$$\chi^{(r)} = \frac{c\lambda n_r}{2.4 \times 10^4 \pi^2 L_{eff}} \frac{dN}{dI} \quad (4)$$

$$= \frac{n_r^2 c}{12\pi^2 \times 10^3} n_r$$

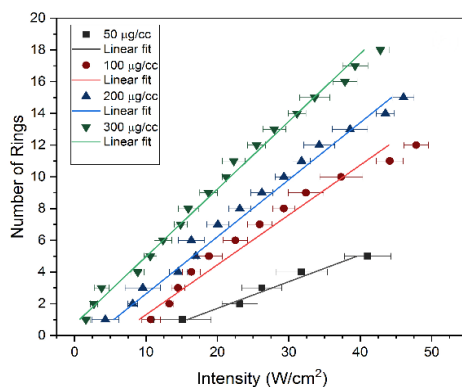
که c سرعت نور و λ طول موج لیزر است.

برای اندازه‌گیری توان پرتوها فرودی از توان سنج شرکت ThorLab و ثبت طرح‌های پراش حلقوی از دوربین دیجیتال Canon استفاده شد.

نتایج و بحث

شکل (۳) و شکل (۴) به ترتیب گستره تغییر شدت توان متمرکز شده در نمونه اکسیدگرافن در حلال NMP را بر حسب تعداد حلقه‌های تشکیل شده، و نیز الگوی های مشاهده شده حلقه‌های متمرکز را در چهار غلظت نشان می‌دهند. همانگونه که دیده می‌شود با افزایش شدت پرتو از کم به زیاد، تعداد حلقه‌ها نیز افزایش می‌یابد. نکته‌ای که حائز اهمیت است، آن است که این تغییرات بصورت خطی رخ می‌دهد و با افزایش غلظت شیب خط افزایش می‌یابد.

می‌توان مشاهده کرد که با افزایش غلظت، توان آستانه‌ای که با استفاده از آن اولین حلقه پراش SSPM را مشاهده می‌کنیم نیز کاهش پیدا می‌کند. عدم تقارن مشاهده شده حلقه‌ها، ناشی از تغییرات حرارتی نمونه قسمت بالایی و



شکل ۳: تغییرات تعداد حلقه‌ها بر حسب تغییر شدت توان برخوردی به محلول اکسیدگرافن کاهیده شده در غلظت‌های مختلف

برهم‌نهی نقاط گوناگون، طرح‌های تداخلی پراش به وجود خواهد آمد که به صورت نواحی تاریک و روشن دیده می‌شوند. تغییر فاز ایجاد شده در جبهه موج طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود [۸]:

$$\Delta\phi(r) = \frac{2\pi n_0}{\lambda} \int_0^{L_{eff}} \Delta n(r, z) dz \quad (1)$$

در این رابطه Δn تغییرات ضریب شکست در راستای عرضی است. در واقع، چنانچه تغییرات جبهه موج بر اثر تغییرات ضریب شکست، کمتر از π باشد، آنگاه رویداد خود-کانونی و خود-واکانونی پرتو غالب خواهد بود. از سوی دیگر اگر تغییرات فاز جبهه موج بیشتر از π باشد، محیط منجر به رویداد مدولاسیون خود-فازی فضایی (SSPM) و مشاهده نمایی حلقه‌های متحدالمرکز پرتو برهمکنش در میدان دور خواهد شد. زمانی که شدت پرتو از کم به زیاد افزایش پیدا می‌کند تعداد حلقه‌ها نیز از کم به زیاد تغییر می‌کند. این تغییر به صورت خطی انجام می‌شود که با شیب خط این تغییرات می‌توان ضریب شکست غیرخطی و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم غیرخطی ماده را محاسبه کرد. ضریب شکست غیرخطی ماده را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد [۸]:

$$n_r = \frac{\lambda}{2 n_{eff}} \frac{N}{I} \quad (2)$$

که در اینجا λ طول موج لیزر، n_0 ضریب شکست خطی حلال NMP، N تعداد حلقه‌های پراش و I شدت نور فرودی به ماده مورد بررسی است. در این معادله L_{eff} طول موثر ماده اپتیکی در زمان برهمکنش نور لیزر با ماده است که از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$L_{eff} = \int_{L_1}^{L_2} \left(1 + \frac{z^2}{z_0^2}\right)^{-1} dz \quad (3)$$

z فاصله ماده تا روزنه و z_0 طول ریلی است. پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم غیرخطی نمونه با استفاده از کمیت n_r ماده و به صورت زیر محاسبه می‌شود (۸).

شد. می توان از این روش برای اندازه گیری سایر محیط های غیرخطی استفاده کرد.

مرجع ها

[۱] Partoens, B., & Peeters, F. M. (۲۰۰۶). From graphene to graphite: Electronic structure around the K point. *Physical Review B*, 74(۷), ۰۷۵۴۰۴.

[۲] Nair, R. R., Blake, P., Grigorenko, A. N., Novoselov, K. S., Booth, T. J., Stauber, T., & Geim, A. K. (۲۰۰۸). Fine structure constant defines visual transparency of graphene. *Science*, 320(۵۸۸۱), ۱۳۰۸-۱۳۰۸.

[۳] Bolotin, K. I., Sikes, K. J., Jiang, Z., Klima, M., Fudenberg, G., Hone, J., & Stormer, H. L. (۲۰۰۸). Ultrahigh electron mobility in suspended graphene. *Solid state communications*, 146(۹-۱۰), ۳۵۱-۳۵۵.

[۴] Stobinski, L., Lesiak, B., Malolepszy, A., Mazurkiewicz, M., Mierzwa, B., Zemek, J., & Bieloshapka, I. (۲۰۱۴). Graphene oxide and reduced graphene oxide studied by the XRD, TEM and electron spectroscopy methods. *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena*, 195, ۱۴۵-۱۵۴.

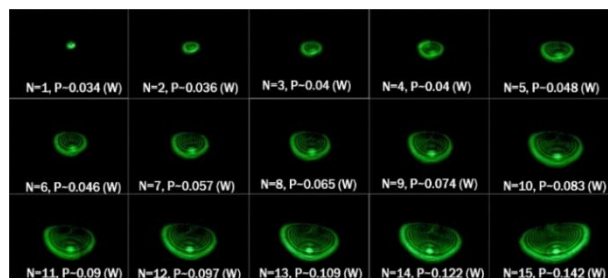
[۵] Ferrari, A. C., & Basko, D. M. (۲۰۱۳). Raman spectroscopy as a versatile tool for studying the properties of graphene. *Nature nanotechnology*, 8(۴), ۲۳۵-۲۴۶.

[۶] Bao, Q., Zhang, H., Wang, Y., Ni, Z., Yan, Y., Shen, Z. X., & Tang, D. Y. (۲۰۰۹). Atomic-layer graphene as a saturable absorber for ultrafast pulsed lasers. *Advanced Functional Materials*, 19(۱۹), ۳۰۷۷-۳۰۸۳.

[۷] Sheik-Bahae, M., Said, A. A., Wei, T. H., Hagan, D. J., & Van Stryland, E. W. (۱۹۹۰). Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam. *IEEE journal of quantum electronics*, 26(۴), ۷۶۰-۷۶۹.

[۸] Shan, Y., Tang, J., Wu, L., Lu, S., Dai, X., & Xiang, Y. (۲۰۱۹). Spatial self-phase modulation and all-optical switching of graphene oxide dispersions. *Journal of Alloys and Compounds*, 771, ۹۰۰-۹۰۴.

[۹] Wang, G., Zhang, S., Umran, F. A., Cheng, X., Dong, N., Coghlan, D., & Wang, J. (۲۰۱۴). Tunable effective nonlinear refractive index of graphene dispersions during the distortion of



شکل ۴: طرح پراش SSMP در محلول (۲۰۰ μg/cc) از اکسید گرافن در NMP

پایینی منطقه کانونی شده پرتو است. در جدول ۱ مقادیر ضریب شکست غیرخطی n_2 و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم غیرخطی ماده χ^3 محاسبه شده برای نمونه های مختلف با غلظت های گوناگون گزارش شده است. در این مقاله نشان داده شده است که با افزایش تراکم اکسید گرافن کاهیده در حلال، رفتار اپتیکی غیر خطی ماده تغییر می یابد.

جدول ۱: مقادیر ضریب شکست غیرخطی و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه

(μg/cc)	سوم غیرخطی ماده		
	n_2	$\chi^{(3)}$	
	$\times 10^{-7}$ (cm ² /W)	$\times 10^{-11}$ (e.s.u)	$\times 10^{-3}$ (m ² /V ²)
۵۰	۳۰,۴±۳,۳۰	۱۶,۷±۱,۸۱	۱۱,۹±۱,۲۹
۱۰۰	۵۶,۹±۳,۳۵	۳۱,۲±۱,۸۴	۲۲,۳±۱,۳۱
۲۰۰	۶۵,۲±۱,۹۴	۳۵,۷±۱,۰۶	۲۵,۵±۰,۷۶
۳۰۰	۷۷,۲±۱,۵۳	۴۲,۳±۱,۳۸	۳۰,۲±۰,۶۰

نتیجه گیری

در این پژوهش با استفاده از روش مدولاسیون خودفاز فضایی رفتار اپتیکی غیرخطی غلظت های متفاوت اکسید گرافن در حلال NMP بررسی شد. با استفاده از این روش ضرایب شکست غیرخطی و پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم به ترتیب از مرتبه 10^{-7} cm²/w و 10^{-11} e.s.u اندازه گیری